## 补充材料

## 二维 SiSnF<sub>2</sub> 中非磁性缺陷的影响和量子尺寸效应<sup>\*</sup>

刘文超 罗朝波 谢紫彤 彭向阳\*

(湘潭大学物理与光电工程学院,微纳能源材料与器件湖南省重点实验室,

## 湘潭 411105)

本文的声子谱计算由 PHONOPY<sup>[S1,S2]</sup>代码结合使用 VASP 中的密度泛函扰动 理论方法实现。为了确定二维 SiSnF<sub>2</sub> 的室温稳定性,使用 VASP 进行了第一性 原理分子动力学模拟。我们使用应变-能量法<sup>[S3]</sup>计算了体系的弹性常数,体系的 独立弹性常数列于表 S1 中。根据二维六角晶格的机械稳定性判据<sup>[4]</sup>,  $C_{11}$ >0,  $C_{11}>|C_{12}|$ ,可以知道体系在无应变和 5%应变的情形下都满足判决,是机械稳定 的。计算了 SiSnF<sub>2</sub> 未加应变( $\epsilon = 0$ %)及其应变( $\epsilon = 5$ %)情况下的声子谱,分别如 图 S1(a)和图 S1(b)显示。可以看到,所有的振动模式都是实频率,这表明它们是 动力学稳定的。

	З	
	0%	5%
$C_{11}/({\rm N~m}^{-1})$	33.341	19.233
$C_{12}/({\rm N~m}^{-1})$	7.544	5.155

表 S1 无应变和 5%应变情形下体系的弹性常数 Table S1. Elastic constants of the system under 0% and 5% strained.

为了研究 SiSnF<sub>2</sub> 单层的热稳定性,使用第一性分子动力学,对二维 SiSnF<sub>2</sub> 单层做了分子动力学模拟。我们使用了一个足够大的用于热平衡的 6×6 超胞,一 共 144 个原子。设置时间步长为 2 fs,在 300 K 的温度下,使用 NVT 系综, Nose-Hoover 热浴控温,进行了 10 ps 的模拟。体系的总能量和温度波动随模拟 时间的变化如图 S1(c)和 S1(d)所示。体系的总能随模拟时间在均值-663.88 eV 附近波动,波动幅度约为 5 eV,小于 0.8%,这是满足热平衡情况下的涨落的。 Si—Sn, Si—F和 Sn—F 的平均配位数分别为 3,1 和 1,并且 Si—Sn, Si—F 和 Sn—F 的平均键长分别为 2.70 Å,1.65 Å 和 1.96 Å,与基态下的结构参数进行比 较,表明 SiSnF<sub>2</sub> 的化学键没有破坏。我们检查最终的几何结构,没有观察到结 构重建或者被破坏。施加了 5%应变的 SiSnF<sub>2</sub> 单层,体系总能在均值-660.89 eV 附近波动,波动幅度小于 0.6%。Si—Sn,Si—F和 Sn—F 的平均配位数分别为 3, 1 和 1,并且 Si—Sn,Si—F和 Sn—F 的平均键长分别为 2.80 Å,1.65 Å 和 1.96 Å。 这些结果表明二维的 SiSnF<sub>2</sub>在室温(*T* = 300 K)下是热稳定的。



图 S1 (a), (b)分别是施加应变 0%和 5%应变的体系的声子谱; (c), (d)分别是施加应变 0%和 5%应变的体系在 300 K 的第一性原理分子动力学结果,其中顶部和底部分别对应总能和温度随时间的变化。

Fig. S1. (a), (b) Phonon spectra of the system under 0% and 5% strain, respectively; (c), (d) the first-principles molecular dynamics results of the system at 300 K under 0% and 5% strain, respectively. The top and bottom parts correspond to the total energy and temperature changes over time, respectively.

综合上述结果,应变前后( $\varepsilon = 0$ %和 $\varepsilon = 5$ %)的晶体结构都具有动力学、热学

和机械稳定性。

参考文献

- [S1] Togo A, Oba F, Tanaka I 2008 Phy. Rev. B 78 134106
- [S2] Togo A, Tanaka I 2015 Scripta Mater. 108 1
- [S3] Wang V, Xu N, Liu J C, et al. 2021 Comput. Phys. Commun. 267 108033
- [S4] Wang V, Tang G, Liu Y C, et al. 2022 J. Phys. Chem. Lett. 13 11581